

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им.  
А.Ф. Иоффе Российской академии наук**  
объявляет конкурс на замещение вакантной должности  
**научного сотрудника**  
в лаборатории полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей  
**Вакансия VAC 105389**

**Тематика исследований**

Исследования в области прямой ионной литографии структур на основе полупроводниковых материалов, в том числе исследование процессов травления слоистых композитных структур металл/диэлектрик/полупроводник.

**Трудовая деятельность**

- Проведение научных исследований и разработок под руководством заведующего лабораторией согласно государственному заданию и плану НИР.
- Теоретическое и экспериментальное исследование процессов травления слоистых композитных структур металл/диэлектрик/полупроводник. Выявление доминирующих технологических параметров, влияющих на геометрические параметры литографического рисунка.
- Разработка технологических основ формирования сфокусированным ионным пучком оптических элементов для формирования модового состава излучения полупроводниковых лазеров.
- Сбор, обработка и анализ научно-технической информации. Составление отчетов по экспериментальной и исследовательской работе.
- Участие в подготовке публикаций результатов научно-исследовательских работ в журналах, индексируемых Web of Science и/или Scopus. Представление результатов на российских и международных конференциях. Участие в работе по регистрации результатов интеллектуальной деятельности.

**Требования к претенденту**

- высшее техническое образование (инженер или физик) не ниже уровня специалист/магистр;
- наличие публикаций в реферируемых журналах и трудах конференций не менее 30 за последние 5 лет;
- участие в НИР по проектам российских фондов, хозяйственным договорам и программам министерств и ведомств РФ (не менее 5 за последние 5 лет);
- наукометрические показатели: индексы Хирша по WoS и Scopus DB – не ниже 4;
- опыт научной деятельности: не менее 5 лет;
- высокий уровень знания принципов технологии прямой литографии сфокусированным ионным пучком, опыт разработки технологических подходов для формирования сфокусированным ионным пучком устройств на основе полупроводниковых структур, знания принципов работы полупроводниковых лазеров и исследования их оптических характеристик, навыки исследования полупроводниковых гетероструктур методами оптической, растровой электронной, растровой ионной и атомно-силовой микроскопии, навыки расчёта оптических систем, навыки разработки исследовательских стендов, навыки математической обработки и анализа экспериментальных данных, навыки составления научно-технической документации.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 27 228 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45